

03

产线动静态设备ME100DS-PIM

新型功率器件产线动静态ATE解决方案



基于AccoTEST STS
8200平台打造，高
效率，高稳定性

平台出货台数：3000台+
运行年限：10年+

动静态一体机，
两站并行测试

动态：电压：1200V
电流：4000A

静态：电压：2000V
电流：1000A/2000A

专有短路保护装置，
拓宽测量范围，快
速保护被测对象及
设备

短路电流：12000A
短路保护时间：<2us
寄生电感：≤15nH

亮点

ME100DS-PIM 产品规格

测试对象	IGBT, SiC MOSFET, GaN HEMT, IPM
测试项目	动态 (单脉冲, 双脉冲, 多脉冲, 二极管开关特性测试, RBSOA, SCSOA) 静态 (漏电流, 击穿电压, 导通压降, 二极管导通电压, 垮导, NTC电阻)
测试范围	静态 (2000V, 2000A), 动态 (1200V, 4000A), 短路电流12000A
软件功能	可编程测试, 可对比波形, 实时生产监控, 可自检校准, 过流保护
负载电感	10/25/50/100μH(可任意扩展与切换)
加热范围	室温~200°C
UPH	300 (单相模块测试速度)
寄生电感	≤15nH
栅极驱动	电压: -30-30V (最高可至 35V, ±0.10V)Q _G :1mA ~ 150mA
门极电阻	软件操控, 多挡调节 (可定制)
采样设备	虚拟示波器 (PICO): 200MHz, 采样速率 (可定制): 12-bit

DC指标	测试范围	AC指标	测试范围
I _{GES}	V _{GE} -100V~100V I _{GE} -10A~10A	IGBT Switching Test I _{CE} , I _{CE_PEAK} , V _{CE_PEAK} , t _{on} , t _{off} , t _{don} , t _{doff} , T _{FI} , T _{RI} , T _{FV} , T _{RV} , E _{on} , E _{off} , di/dt _(on) , di/dt _(off) , dv/dt _(on) , dv/dt _(off)	Up To 1200V Up To 4000A
V _{th}	V _{GE} -100V~100V I _{GE} -10A~10A	Diode Switching Test T _{rr} , Q _{rr} , E _{rr} , I _{rr} , di/dt _(on) , di/dt _(off) , dv/dt _(on) , dv/dt _(off)	Up To 1200V Up To 4000A
BV _{CES}	V _{CE} -2000V~2000V(Can upgrade to ±3000V) I _{CE} -20mA~20mA	Short-Circuit Curre (SCSOA) T _{SC} , I _{SC} , V _{CE_PEAK} , I _{CE_PEAK}	Up To 1200V Up To 12000A
I _{CES}	V _{CE} -2000V~2000V(Can upgrade to ±3000V) I _{CE} -20mA~20mA	I_Latch I _{CE} , V _{CE} , V _{CE_PEAK} , T _{FI} , T _{FV} , di/dt _(on) , di/dt _(off) , dv/dt _(on) , dv/dt _(off)	Up To 1200V Up To 4000A
V _{CEsat}	V _{GE} -100V~100V I _{GE} -10A~10A V _{CE} -100V~100V I _{CE} 0~2000A	Q _G	Up To 1200V Up To 4000A
V _F	V _{GE} -100V~100V I _{GE} -10A~10A V _{CE} -100V~100V I _{CE} 0~2000A	RBSOA	Up To 1200V Up To 4000A
GFS	V _{GE} 0~20V I _{CE} 0~2000A V _{CE} 0~30V		
NTC	V _{NTC} -100V~100V I _{NTC} -10A~10A		